

Spezifikationen	
Teilenummer	TPH3207WS
Hersteller	Transphorm
Beschreibung	GAN FET 650V 50A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2514 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.65V @ 700μA
Vgs (Max)	±18V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 32A, 8V
Verlustleistung (max)	178W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2197pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

sein:			
TPH3206PSB Transphorm GAN FET 650V 16A TO220	TPH3208PD Transphorm MOSFET N-CH 650V 20A TO220	TPH3206LSB Transphorm GAN FET 650V 16A PQFN88	TPH3206PD Transphorm GAN FET 600V 17A TO220
TPH3208LDG Transphorm GAN FET 650V 20A PQFN88	TPH3208LD Transphorm GAN FET 650V 20A PQFN88	TPH3208LSG Transphorm MOSFET N-CH 650V 20A 3PQFN	TPH3206LS Transphorm GAN FET 600V 17A PQFN88

TPH3207WS Transport	TPH3207WS Datenblatt	TPH3207WS-Datenblätter	TPH3207WS PDF	Transphorm TPH3207WS
TPH3207WS Electronic	TPH3207WS-Komponenten	TPH3207WS-Verteiler	TPH3207WS-Bild	TPH3207WS-Teil
TPH3207WS Preis	TPH3207WS Hersteller	TPH3207WS Bild	TPH3207WS Aktie	TPH3207WS Inventar
TPH3207WS Neu	TPH3207WS Original	TPH3207WS garantiert	TPH3207WS RFQ	TPH3207WS Online bestellen